PAT-NO: JP354112164A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 54112164 A

TITLE: MANUFACTURE OF SEMICONDUCTOR DEVICE

PUBN-DATE: September 1, 1979

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

IGUCHI, JUNJI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME COUNTRY NEC HOME ELECTRONICS LTD N/A

APPL-NO: JP53020171

APPL-DATE: February 22, 1978

INT-CL (IPC): H01L021/78
US-CL-CURRENT: 29/25.01

#### ABSTRACT:

PURPOSE: To simplify the breakaway of an element with the contact strength between the element and a thin plate weakened by sticking a semiconductor wafer with notch lines among many formed semiconductor elements to a flexible thin plate and by turning this thin plate supported on a support stand in a curved shape by a fixed angle.

CONSTITUTION: Semiconductor wafer 1 with several semiconductor elements 2 formed is provided with notch lines 4 and 5 and then stuck to flexible thin plate 3. Next, this thin plate 3 is held on spherical support stand 9 provided with ring- shaped concave grooves 10 at adequate positions and shifted fixed angle by fixed angle to cause wafer 1 to generate bending force, so that wafer 1 will be divided at notch lines 4 and 5. Next, thin plate 3 is pushed against the spherical surface of support stand 9 and fixed to concave grooves 10 by using wedges 11. In this way the contact strength of each element 2 to thin plate 3 is weakened and each element 2 is broken away by collet 12. Consequently, the automatic mounting of each element is simplified.

COPYRIGHT: (C) 1979, JPO& Japio

# ⑩公開特許公報 (A)

昭54-112164

⑤Int. Cl.²H 01 L 21/78

識別記号 **②日本分類** 99(5) A 04

庁内整理番号 ❹公開 昭和54年(1979)9月1日 6123-5F

> 発明の数 1 審査請求 未請求

> > · (全 3 頁)

#### ⑤半導体装置の製造方法

顧 昭53-20171

②出 願 昭53(1978) 2 月22日

@発 明 者 井口順二

大阪市北区梅田1丁目8番17号 新日本電気株式会社内

切出 願 人 新日本電気株式会社

大阪市北区梅田一丁目8番17号

明 絀 #

発明の名称

20特

半導体装置の製造方法

### 特許請求の範囲

多数の半導体素子を形成し可撓性薄板に貼着された半導体ウェハに刻目線を刻設し、前記可撓性薄板を少なくとも一方向が曲面状の支持台上に支持し、この支持台を所定角度ずつ回動させて、半導体素子を可撓性薄板から剝離することを特徴とする半導体装置の製造方法。

#### 発明の詳細な説明

本発明は半導体装置の製造方法に関する。

トランジスタ,サイリスタ,ダイオード等の半 導体装置は、一般に次のようにして製造されている。まず第1図に示すように、一枚の半導体ウエ ハ1に多数の半導体素子2を形成し、この半導体 ウェハ1をビニルシート等の可挽性薄板3に貼着

各半導体要子2、2間にダイヤモン ザー光線あるいはダイシングソウによりx方向お よび Y 方向の刻目線 4 , 5 を刻設する。次いで第 2 図に示すよらに、平坦な支持台 6 上にゴム板等 の弾性板?を敷き、この弾性板?上に、前配可撓 性薄板3上に貼着され刻目線4,5が刻設された 半導体ウェハ1を、この半導体ウェハ1を下側に 向けて載置し、可撓性薄板3の止から鋼製のロー **ラ8を押圧しながら転動させて、半導体ウェハ1** をまず刻目線4(または5)に沿つて分割し、し かるのちローラ 8 をこれと 9 0 度の方向に押圧転 動させて刻目線5(または4)に沿つて分割して いる。このようにすれば、半導体ウェハ1から分 割された半導体素子2が、半導体ウェハ1の状態 時と何様に規則正しく配列されている。したがつ て、後の各半導体素子2をステム,リードフレー ム等の放熱板(図示せず)にマウントする作業が やり易くなる。なお、この状態では、各半導体素 子2が接触状態で並置されているので、コレット 等により各半導体素子2を可撓性薄板3から剝離

それゆえ、本発明の主たる目的は、各半導体素子と可挽性薄板の密着力が低減されるかつ各半導体素子の自動マウント化が容易を製造方法を提供することである。

本発明は要約すると、多数の半導体案子が形成され可撓性薄板に貼着された半導体ウェハに刻目 線を刻設し、前記可撓性薄板を少なくとも一方向

3 から剝離することができる。また、支持台10 を図示矢符方向に所定角度ずつ、すなわち半導体素子2の1個分に相当する角度だけ間欠的に回動させながら、コレット12を上下動していけば、自動マウント化が行なえる。

なお、上記実施例において、半導体ウェハに機配力を作用せしめる場合、可機性薄板3の周囲を把持固定しておいて、支持台9を上方に押し上げてもよいし、これとは逆に支持台9を固定にししておいて、可機性薄板3の周囲を把持して下方に押し下げてもよい、また必要ならば、支持台9の球状要面に対応する球状凹面を有する補助部材(図示せず)により、半導体ウェハ1を押圧してもよい。

さらにもし、必要ならは、第2図に示す従来方法によつて半導体ウェハ1を刻目線4,5に沿つて分割したのち、球面状の支持台9に装着してもよい。

あるいは、上記支持台のは球状表面を有する場合について説明したが、例えば一方向のみに曲面

が曲面状の支持台上に支持し、この支持台を所定 角度ずつ回動させて、半導体案子を可挽性薄板か ら剝離することを特徴とする。

本発明の上述の目的およびその他の目的と特徴 は、図面を参照して行なり以下の静細な説明から 一層明らかとなろう。

第3図は本発明のようにはないにはないので、1は成れのではないにはないので、2が第1にはないので、2が第1にはないので、2が第2にはないので、2が第2にはないので、2が第2にはないので、2が第2にはないので、2が第2にはないので、2が第2にはないので、2が形式では、2が第2にはないが、3が第2には、2が第3には、2が第3には、2が第3には、2が第3には、2が第3には、2が第3には、2が第3には、2が第3には、2が第3には、2が第3には、2が第3には、2が第3には、2が第3には、2が第4には、2が第4には、2が第4にが第4には、2が第4には、2が第4には、2が第4には、2が第4には、2が第4には、2が第4には、2が第4には、2が第4には、2が第4には、2が第4には、2が第4にが第4には、2が第4にが第4には、2が2はは、2

状の支持台を用いてもよい。 この場合、半導体ウェハ1の分割は 2回に分けて実施しなければならないが、支持台を所定角度だけ回動せしめるための機構が著しく簡単になるという利点がある。

## 図面の簡単な説明

第1図は可挽性薄板に貼着された半導体ウェハの斜視図、第2図は半導体ウェハの分割方法例を 説明するための縦断面図、第3図および第4図は 本発明の一実施例方法を説明するための縦断面図 である。

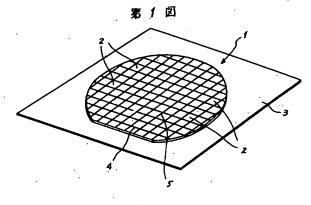
1 ...... 半導体ウェハ、 2 ...... 半導体素子、

3 …… 可撓性薄板、 4 , 5 …… 刻目線、

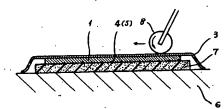
9 ..... 支持台。

特許出願人

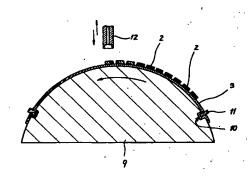
新日本電気株式会社



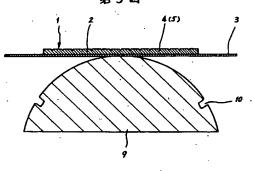
第2 図



第4回



第3回



-371-.